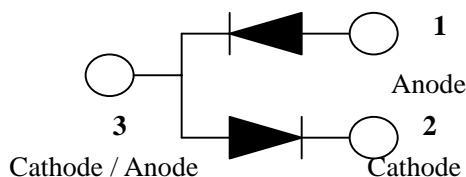




Schottky Diode



肖特基二极管(FHBAS70-04)

MAXIMUM RATINGS 最大额定值

| Rating 额定值 | Symbol 符号 | Value 值 | Unit 单位 |
|---|-----------------|---------|---------|
| Reverse Voltage 反向电压 | V_R | 70 | Vdc |
| Peak Forward Current 正向峰值电流 | I_F | 70 | mAdc |
| Peak Forward Surge Current 正向最大浪涌电流 t 1s | $I_{FM(surge)}$ | 100 | mAdc |

THERMAL CHARACTERISTICS 热特性

| Characteristic 特性 | Symbol 符号 | Max 最大值 | Unit 单位 |
|--|----------------|-------------------|---------|
| Total Device Dissipation FR-5 Board(1) $T_A=25$ | P_D | 225 | mW |
| Total Device Dissipation Alumina Substrate,(2) $T_A=25$ 总耗散功率 氧化铝衬底 | P_D | 300 | mW |
| Junction and Storage Temperature 结温和储存温度 | T_J, T_{stg} | 150 , -55 to +150 | |

DEVICE MARKING 打标

FHBAS70-04=K2

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 电特性($T_A=25$ unless otherwise noted 如无特殊说明, 温度为 25)

| Characteristic 特性 | Symbol 符号 | Min 最小值 | Max 最大值 | Unit 单位 |
|-------------------|-----------|---------|---------|---------|
|-------------------|-----------|---------|---------|---------|

OFF CHARACTERISTICS 截止电特性

| | | | | |
|---|------------|----|------|--------------|
| Reverse Voltage Leakage Current 反向漏电流($V_R=50Vdc$) | I_R | — | 0.1 | μA_{dc} |
| Reverse Breakdown Voltage 反向击穿电压($I_{BR}=10 \mu A_{dc}$) | $V_{(BR)}$ | 70 | — | Vdc |
| Forward Voltage 正向电压 ($I_F=1mA_{dc}$) | V_F | — | 410 | mVdc |
| ($I_F=10mA_{dc}$) | | — | 750 | |
| ($I_F=15mA_{dc}$) | | — | 1000 | |
| Total Capacitance 电容($V_R=0V, f=1.0MHz$) | C_T | — | 2 | pF |

- FR-5=1.0 × 0.75 × 0.062 in.
- Alumina=0.4 × 0.3 × 0.024 in. 99.5% alumina.



SOT-23 封装外形尺寸 (SOT-23 DIMENSION)

